

T22: Etching Technology for Nitride Semiconductors

# 窒化物半導体エッチング技術

～高制御性と低損傷性を求めて～

2019年 9月20日 (金)

13:30～18:00 (予定)

北海道大学・札幌キャンパス



窒化物半導体では、通常のウェットエッチングがそのまま適用しづらい特有の事情から、それに代わる様々なエッチング技術が提案されてきました。本シンポジウムでは、近年急速な進展を見せている「窒化物半導体エッチング技術」とそのデバイス応用、加工ダメージの評価について、第一線で活躍されている研究者を講師にお迎えし、最新の研究についてご紹介いただきます。また、一般講演も交えながら、様々なエッチング手法について、加工制御性・低損傷性などの観点から深く議論します。

伊藤昌平 (オックスフォード・インストゥルメンツ)  
ALEによるGaNのエッチング

佐野泰久 (大阪大学)  
触媒表面基準エッチング法によるGaN基板の無歪研磨

塩島謙次 (福井大学)  
界面顕微光応答法によるエッチングダメージの2次元評価

菅原健太 (住友電気工業)  
塩素中性粒子ビームエッチングを用いたGaN HEMT高性能化

堀切文正 (サイオクス)  
GaNウェットエッチング

三島友義 (法政大学)  
PECエッチングによるメサ構造GaN p-n接合ダイオード

山田真嗣 (名古屋大学)  
Slope-down-biasエッチング法によるプラズマダメージの低減

